

Phototransistor de 3 mm SFH309

Siemens



- Phototransistor NPN silicium, spécialement adapté pour des applications entre 380 nm et 1150 nm.
- Linéarité élevée.
- Boîtier plastique 3 mm.
- Applications principales en électronique industrielle et circuits de commande/contrôle.

Spécifications techniques

Longueur d'onde de sensibilité max.: 860 nm

Tension collecteur-émetteur V_{CE} (max.): 35 V

Courant collecteur I_C (max.): 15 mA

Puissance dissipée max.: 165 mW

Dimensions: Ø 2,9-3,1 mm ; h 5,2 mm

Repérage collecteur: patte la plus courte

Température d'utilisation: -55°C à +100°C

réf.	photocourant	angle	t_r/t_f
Siemens	($\lambda=950$ nm ; E=0,5 de détection mW/cm ²)		(μ s)
SFH309	1,0 à 3,2 mA	24°	7

U.D.V.=5

réf.	code	
Siemens	commande prix de l'U.D.V.	
	1-4	5+
SFH309	195-631 Fr 23.29	Fr 20.96